








	<h2>SPD04N60C3BTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD04N60C3BTMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 4.5A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD04N60C3BTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD04N60C3BTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 4.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	950 mOhm @ 2.8A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	490pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

SPD04N60C3BTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD04N60C3BTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD04N60C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD04N60C3BTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD04N60C3ATMA1</b> Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY</p>	 <p><b>SPD04N60C3G</b> Original SPD04N60C3G Original</p>	 <p><b>SPD04N60C3</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 4.5A TO252-3</p>	 <p><b>SPD04N60C3</b> IGBT Module IGBT Modules</p>
 <p><b>SPD04N60S5</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-252</p>	 <p><b>SPD04N60C2</b> INF SPD04N60C2 INF</p>	 <p><b>SPD04N80C3ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 4A 3TO252</p>	 <p><b>SPD04N60S5BTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 4.5A TO252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD04N60C3BTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD04N60C3BTMA1 Datenblatt	SPD04N60C3BTMA1-Datenblätter	SPD04N60C3BTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD04N60C3BTMA1
SPD04N60C3BTMA1 Electronic	SPD04N60C3BTMA1-Komponenten	SPD04N60C3BTMA1-Verteiler	SPD04N60C3BTMA1-Bild	SPD04N60C3BTMA1-Teil
SPD04N60C3BTMA1 Preis	SPD04N60C3BTMA1 Hersteller	SPD04N60C3BTMA1 Bild	SPD04N60C3BTMA1 Aktie	SPD04N60C3BTMA1 Inventar
SPD04N60C3BTMA1 Neu	SPD04N60C3BTMA1 Original	SPD04N60C3BTMA1 garantiert	SPD04N60C3BTMA1 RFQ	SPD04N60C3BTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited